

## Monolithisch integrierte Schaltungen *Monolithic integrated circuits*

**Anwendung:** Thyristor-Phasenanschnittsteuerung

**Application:** Phase control integrated circuits

**Besondere Merkmale:**

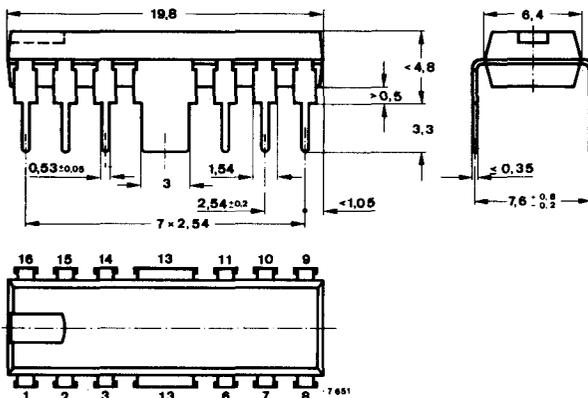
- Phasenanschnittsteuerung, geeignet für Regelschaltungen hoher Präzision
- Getrennte Impulsausgänge für positiv bzw. negativ Netz-Halbwellen
- Impulsbreite der Ausgangsimpulse frei wählbar
- Phasenwinkel zwischen  $>0^\circ$  und  $<180^\circ$  einstellbar
- Hochohmiger Phasenschiebeeingang
- Impulssymmetrie zweier Halbwellen und mehrerer Schaltungen untereinander  $<3^\circ$
- Keine Mehrfachimpulsbildung durch Störsignale am Verschiebeeingang
- Ausgangsimpuls-Sperrung möglich

**Features:**

- Suitable for phase-control in high precision regulators
- Separate pulse outputs for the positive and the negative half-cycle of the sync.signal
- Output pulse-width is freely adjustable
- Phase angle variable from  $>0^\circ$  to  $<180^\circ$
- High-impedance phase shift input
- Less than  $3^\circ$  pulse symmetry between two half-cycles or phase of different integrated circuits
- No multiple pulse generation due to noisy shift input
- Output pulse blocking possible

**Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications**

**Abmessungen in mm  
Dimensions in mm**



Spezialgehäuse  
Kunststoff  
*Special case  
plastic*  
Gewicht · Weight  
max. 1,5 g



Gesamtverlustleistung <i>Total power dissipation</i>						
$t_{amb} \leq 70^\circ\text{C}$		$P_{tot}$		550		mW
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>			$t_j$	125		$^\circ\text{C}$
Umgebungstemperaturbereich <i>Ambient temperature range</i>		<b>UAA 145</b>	$t_{amb}$	-25...+70		$^\circ\text{C}$
		<b>UAA 146</b>	$t_{amb}$	0...70		$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>			$t_{stg}$	-25...+125		$^\circ\text{C}$
<b>Wärmewiderstände</b> <b>Thermal resistances</b>				<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Sperrschicht-Umgebung <i>Junction ambient</i>			$R_{thJA}$		100	K/W
Sperrschicht-Gehäuse <i>Junction case</i>			$R_{thJC}$		35	K/W
<b>Statische Kenngrößen</b> <b>DC characteristics</b>						
$U_{S1} = 13...16\text{ V}$ , $-I_{S13} = 15\text{ mA}$ , Bezugspunkt <i>Reference point</i>			Pin 3,			
$t_{amb} = 25^\circ\text{C}$ , falls nicht anders angegeben <i>unless otherwise specified</i>						
Positiver Versorgungsstrom <i>Positive supply current</i>						
$U_S = 16\text{ V}$	<b>UAA 145</b>	Pin 1	$I_S$	12	30	mA
	<b>UAA 146</b>	Pin 1	$I_S$	12	35	mA
Z-Spannungen Fig. 8 <i>Z-voltages</i>						
$-I_{S13} = 15\text{ mA}$		Pin 13	$-U_Z$	7,0	9,0	V
$-I_{S15} = 3,5\text{ mA}$		Pin 15	$-U_Z$	7,0	9,0	V
$U_S = 13\text{ V}$ , $U_{Syn.9} = 0\text{ V}$		Pin 16	$U_Z$	7,0	9,0	V
Verschiebestrom <i>Shift current</i>						
$U_S = 16\text{ V}$ , $U_{\varphi 8} = 13\text{ V}$ , $U_7 = 0\text{ V}$ , $I_{Syn.9} = 0,3\text{ mA}$		Pin 8	$I_\varphi$		10	$\mu\text{A}$
$C_T$ -Potentialverschiebestrom <i><math>C_T</math>-potential shift current</i>						
$U_S = U_{I2} = 13\text{ V}$ , $U_{I7} = 3\text{ V}$ , $I_{\varphi 8} = 5\mu\text{A}$ , $I_{Syn.9} = 0,3\text{ mA}$		Pin 2	$I_I$	4,5		mA
$C_T$ -Ladestrom <i><math>C_T</math>-charging current</i>						
$U_S = 13\text{ V}$ , $U_{I2} = U_{I7} = U_{\varphi 8} = U_{Syn} = 0\text{ V}$ , $\frac{t_p}{T} = 0,01$ , $t_p \leq 1\text{ ms}$		Pin 2	$-I_I$	10	30	mA

# UAA 145 · UAA 146

Min. Typ. Max.

$C_S$ -Ladestrom

$C_S$ -charging current

$$U_S = I_{I2} = U_{\varphi 8} = 13 \text{ V,}$$

$$U_{I7} = U_{\text{Syn}9} = 0 \text{ V}$$

$$\frac{t_p}{T} = 0,01, \quad t_p \leq 1 \text{ ms}$$

Pin 7  $-I_1$  20 62 mA

Ausgangs-Sättigungsspannung

Output saturation voltage

$$U_S = I_{I2} = 16 \text{ V, } U_{I7} = U_{\varphi 8} = 0 \text{ V,}$$

$$I_{I11} = 50 \mu\text{A}$$

$I_{Q10} = 20 \text{ mA, } -I_{\text{syn}9} = 0,3 \text{ mA}$  Pin 10  $U_{Q\text{sat}}$  0,3 1,0 V

$I_{Q14} = 20 \text{ mA, } I_{\text{syn}9} = 0,3 \text{ mA}$  Pin 14  $U_{Q\text{sat}}$  0,3 1,0 V

## Dynamische Kenngrößen

### AC characteristics

$$t_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C, Fig. 2}$$

Anstiegszeit der Ausgangsspannung Pin 10  $t_r$  0,5  $\mu\text{s}$   
 Rise time Pin 14  $t_r$  0,5  $\mu\text{s}$

Impulsbreite der Ausgangsspannung Fig. 7 Pin 10  $t_p$  0,1 4 ms  
 Pulse width Pin 14  $t_p$  0,1 4 ms

Symmetrie zweier Halbwellen  
 Pulse phasing difference for two half-waves

$$f = 50 \text{ Hz} \quad \Delta\varphi \quad \pm 3^\circ$$

Gleichlauf mehrerer Integrierter Schaltungen Fig. 9  
 Inter IC phasing difference

$$f = 50 \text{ Hz} \quad \Delta\varphi \quad \pm 3^\circ$$

Vordere Impulsendlage Fig. 5  
 Pulse phasing front limit

$$f = 50 \text{ Hz} \quad \varphi_v \quad 177^\circ$$

Hintere Impulsendlage Fig. 4, 5  
 Pulse phasing rear limit

$$f = 50 \text{ Hz} \quad \varphi_h \quad 0^\circ$$

Stromflußwinkel  $\varphi = 0^\circ \dots 177^\circ$  bei  $U_{\varphi 8} = 0,2 \dots 7,5 \text{ V, } \varphi_h = 0^\circ$ , Fig. 5, 6  
 Angle of current flow at

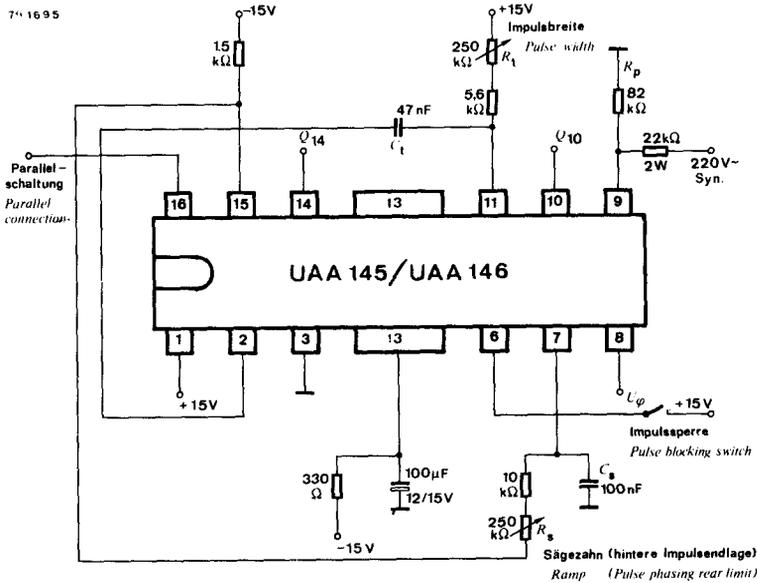


Fig. 2 Meßschaltung für dynamische Kenngrößen  
Test circuit for ac characteristics

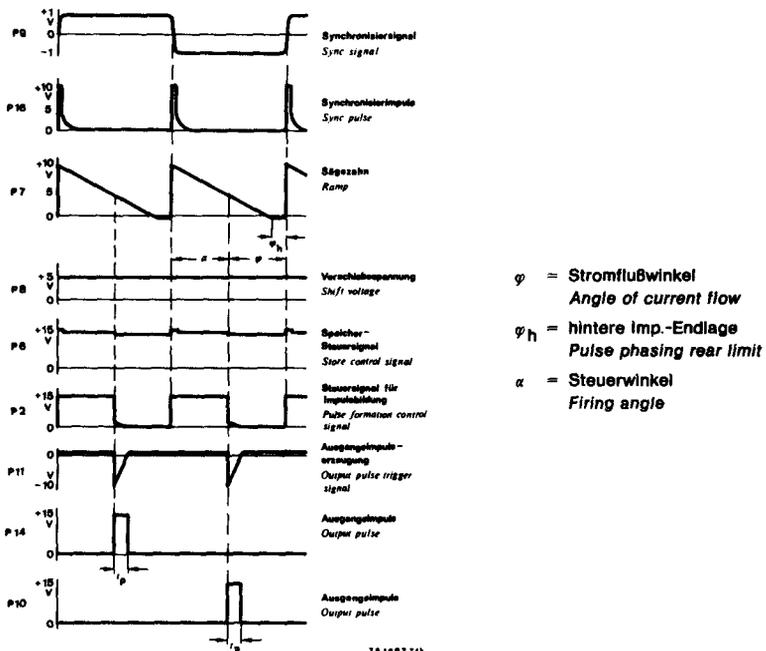
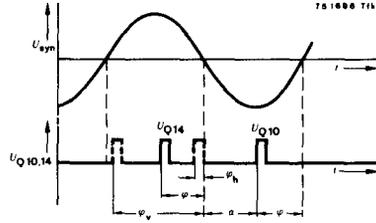
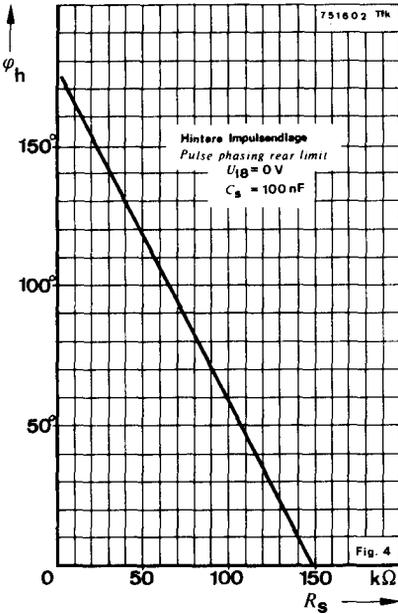
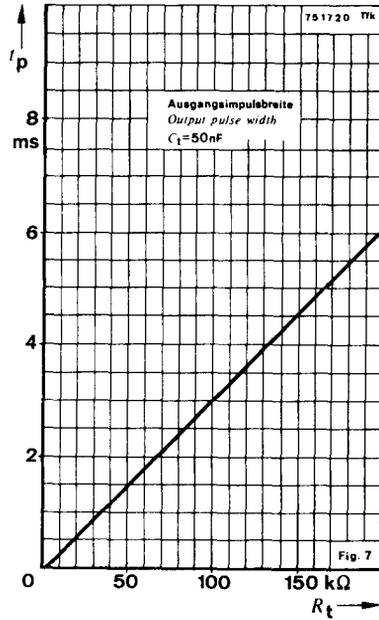
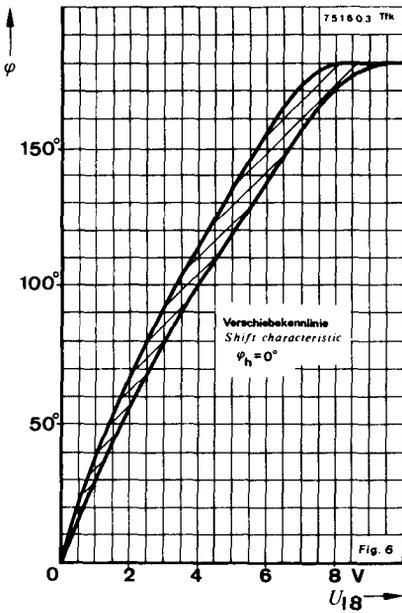


Fig. 3 Impulsdiagramm des UAA 145 · UAA 146  
Impuls diagram of the UAA 145 · UAA 146



- $\varphi$  = Stromflußwinkel  
Angle of current flow
- $\varphi_h$  = hintere Imp.-Endlage  
Pulse phasing rear limit
- $\alpha$  = Steuerwinkel =  $180^\circ - \varphi$   
Firing angle
- $\varphi_v$  = Vordere Impulsendlage  
Pulse phasing front limit
- $\Delta\varphi$  =  $\varphi_{14} - \varphi_{10}$   
Symmetrie zweier Halbwellen  
Pulse phasing symmetry

Fig. 5 Hinterer Impulsendlage  
Pulse phasing rear limit



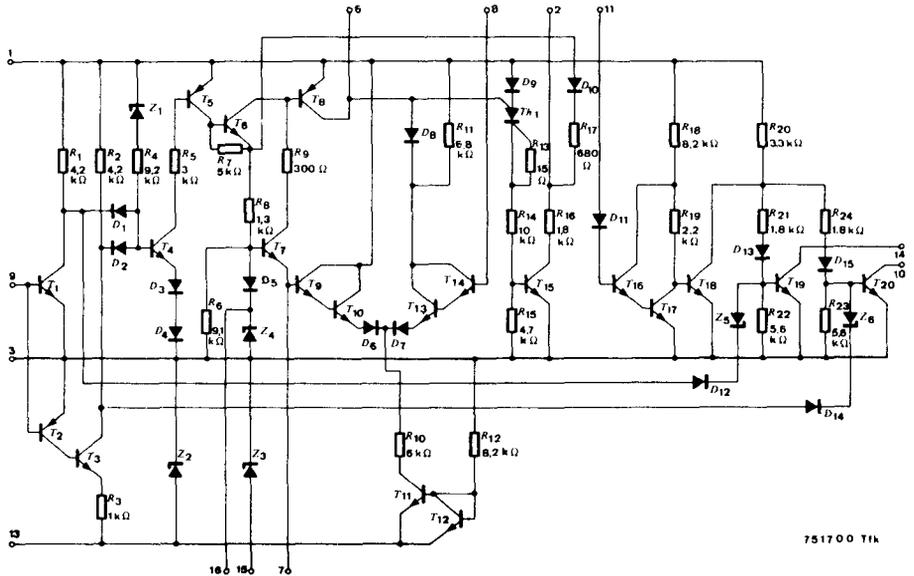


Fig. 8 Schaltung und Anschlußbelegung  
Diagram and pin connections

### Anwendungsbeispiel · Application note

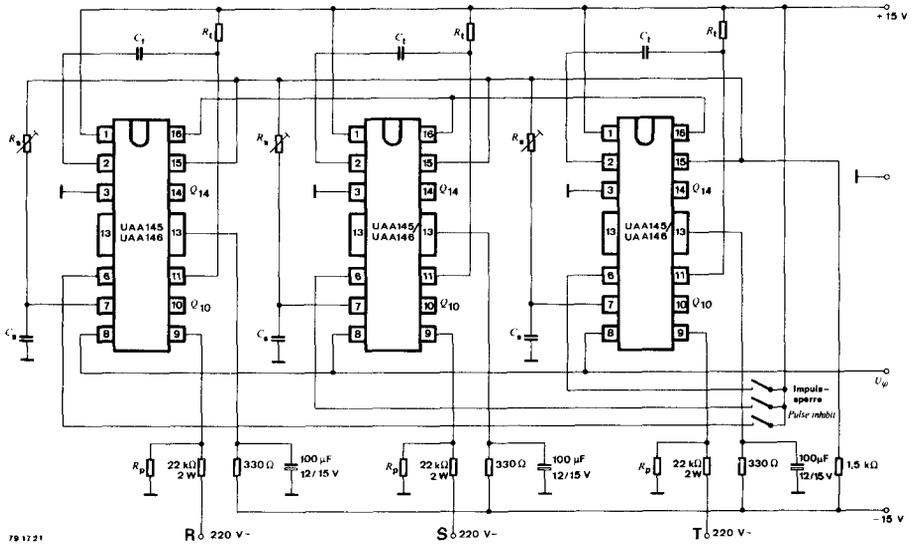


Fig. 9 Parallelschalten von 3 Ansteuerschaltungen für Drehstromanwendungen. Bei Mehrphasenbetrieb werden die Anschlüsse Pin 15 bzw. Pin 16 aller Ansteuerschaltungen untereinander verbunden.  
Parallel connection for three-phase current applications. For polyphase operation connect all Pins 15 and Pins 16.